FT-ICR によるシリコンクラスターイオン(Si_n, n = 10-30)の化学吸着特性の検討 Chemisorption of Silicon Cluster Ions (Si_n, n = 10-30) by using FT-ICR Mass Spectrometer.

(東大工総試*,東大院工**) 丸山茂夫*,**,河野正道*,井上修平**

ABSTRACT

Mass-selected silicon cluster ions were levitated in a Fourier transform ion cyclotron resonance (FT-ICR) mass spectrometer and monitored during chemisorption reaction with ethylene (C_2H_4). Through measurements of "time-dependency" of this reaction process, drastic change of the reactivity depending on the number of absorbed ethylene was observed, in addition to the strong dependency to silicon cluster size. From Si₁₅⁺ to Si₁₈⁺ shows a special stability of Si_xE_y⁺ when x + y = 19, such as Si₁₅E₄⁺.

1.はじめに

薄膜生成プロセスなどで原子・分子クラスターの挙動が重要な問題となり,理論的な興味に加えて,クラスターの基礎的な理解の必要性が高まってきている. 特にシリコンクラスターは,電子素子の微細化およびエッチング反応過程とCVDによる薄膜生成プロセスの解明などの点において重要である.著者らは潜在的に極めて高い質量分解能を有し,クラスターイオンの化学反応実験を数分オーダーで行うことが出来るフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析(Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance, FT-ICR) 装置¹⁾を設計製作し,クラスタービーム源からの直接イオンビーム入射を可能とした.

シリコンクラスターの反応性の研究は主にクラス ターイオンを中心に行われており,10 量体以下の小 さなサイズのクラスター($Si_1^+ \sim Si_7^+$)に CH_3SiH_3 や SiD₄ を反応させると付加物から水素分子や重水素分 子が1~2分子脱離したものが得られ^{2),3)}, NO₂による エッチング反応ではシリコン原子が 1 原子脱離して 反応が進行することが知られている.60 量体程度ま での大きなシリコンクラスターイオンについては, Smalley らの $C_2H_4^{4}$ および $NH_3^{5,6}$ との反応と, Jarrold らの C₂H₄ との反応 ^{7,8)}が知られている.このようにク ラスターサイズが大きくなると、反応生成物は主に付 加体であるいう結果が得られている またこれらのサ イズでは異なる構造を有する構造異性体が多数存在 するようになるので、反応性の測定によってクラスタ ーの構造に関する情報が得られる.今回は FT-ICR を 用いてシリコンクラスターイオンとエチレン分子の 化学反応実験を行い、比較的長時間の反応によって反 応が停止した状態である最終生成物の測定をするこ とが出来たので報告する.

2.実験

FT-ICR 質量分析は強磁場中でのイオンのサイクロ トロン運動に着目した質量分析手法であり、原理的に 10,000 amu 程度までの大きなイオンの高分解能計測 が可能である.その心臓部である ICR セルの概略を Fig. 1 に示す. 内径 42 mm 長さ 150 mm の円管を縦に 4 分割した形で, 2 枚の励起電極(Excite)と 2 枚の検出 電極(Detect)がそれぞれ対向して配置され,その前後 をドア電極(開口 22 mm)が挟む. 一様な磁束密度 B の磁場中に置かれた電荷 q,質量 mのクラスターイオ ンは,ローレンツ力を求心力としたイオンサイクロト ロン運動を行うことが知られており、イオンの速度を v,円運動の半径をrとすると $mv^2/r = qvB$ の関係より, イオンの円運動の周波数 f = qB/2πm となり,比電荷 q/mによって決まる. 質量スペクトルを得るために は,クラスターイオン群に適当な変動電場を加え,円 運動の半径を十分大きく励起したうえで検出電極間 に誘導される電流を計測する.

設計した実験装置の概略を Fig. 2 に示す . ICR セル は内径 84 mmの超高真空用ステンレス管(SUS316)の



Fig. 1 Schematics of ICR cell.

*Shigeo Maruyama, Masamichi Kohno,

Engineering Research Institute, The Univ. of Tokyo. 2-11-16 Yayio Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656

^{**}Shuhei Inoue, Dept. of Mechanical Engineering, The Univ. of Tokyo. 7-3-1 Hongo Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656



Fig. 2 FT-ICR Mass Spectrometer.

中に納められ,この管が NMR 用の6テスラの超電導 磁石を貫く設計となっている.両側のターボ分子ポン プ(300ℓ/s)によって,背圧3×10⁻¹⁰Torrの高真空が実現 できる .クラスター源でイオンビームを生成した場合 には、ヘリウムの超音速で飛行するクラスターイオン を減速する必要があり、パルス電圧の印可可能な減速 管を有する .励起電極には ,パソコンで計算した励起 信号を高速任意波形発生ボードから入力し、検出電極 の出力は差動アンプとデジタルオシロを介してパソ コンに取り込む.ICR セルの前方には,一定電圧に保 つ Front Door と ,クラスタービーム入射時にパルス的 に電圧を下げイオンをセル内に取り込む Screen Door, 後方には Back Door 電極を配置してある .それぞれ± 20V の範囲で電圧を設定でき、減速管で減速されたク ラスターイオンのうち, Front Door の電圧を乗り越え て Back Door の電圧で跳ね返されたものがセル内に



Fig. 3 Cluster Beam Source

留まる設計である.

Fig. 3 に示すクラスター源は,6 インチの 6 方向 UHV クロスにパルスバルブ,サンプル駆動機構,レ ーザー窓,ターボポンプ,スキマーを配置したもので ある.およそ 50µs のヘリウムガスパルスと同期して 蒸発用レーザー(Nd: YAG 2 倍波)をサンプル上に約 1mm に集光する.ノズル形状がフラーレンなどのク ラスターの生成条件と密接に関係するため,ノズル部 分の交換が容易にでき,かつ,サンプルの移動を簡単 な機構で実現できるような設計になっている.

3.結果と考察

Fig. 4 は,レーザー蒸発超音速クラスター源からの FT-ICR への直接導入によって得られたシリコンクラ スター正イオンの質量スペクトルである.Decel は減 速管の電圧を示し,サンプルはシリコンディスクを用 いて,減速管を-10 ~ -30V とに変化させて実験を行 った.-10V の場合は Si₂₀⁺より大きなシリコンクラス ターは十分減速されなかったため ICR セルを通り抜 けてしまい検出されないことが分かる.一方 -30V の 場合は Si₃₀⁺位までサイズのシリコンクラスターが十 分減速されたて検出されている.このことより減速管 の電圧を変えることによって ICR セルにトラップす るクラスターのサイズ領域を調整することができる. なお,シリコンクラスターのほぼ中間に見えるシグナ ルは酸化物である.

Fig. 5 に FT-ICR にて測定した一例としてシリコン クラスター正イオン15量体(Si_{15}^+)とエチレンの化学 反応過程を示す. [Fig.5 (a)]はレーザー蒸発法によっ て生成されたシリコンクラスター正イオンを FT-ICR に直接導入することによって測定した質量スペクト ルである.今回は $Si_{11}^+ \sim Si_{20}^+$ が効率よく ICR セルにト ラップされるように減速管の電圧を調整し,かつ,へ



Fig. 4 Mass Spectra of Silicon Clusters.



リウムキャリアガスを清浄に保ち,サンプル表面を何 度もレーザー蒸発させることで酸化物をおさえた. ICR セルにトラップされたイオンをアルゴンガス (1×10⁻⁵ Torr 5 秒)によって室温程度まで冷却した後, SWIFT (Stored Waveform Inverse Fourier Transform) 呼ばれる手法を用いて目的とするサイズのクラスタ ーイオンのみを ICR セルに残す[Fig.5 (b)]. SWIFT 後, 再度アルゴンガス (1×10⁻⁵ Torr 5 秒) にてクラスター イオンを冷却した後に,反応実験を行う.[Fig.5 (c),(d),(e)] はそれぞれエチレンガス (1×10⁻⁵ Torr) と 0.5,5,15 秒反応させた場合の結果である .0.5 秒反応さ せた場合[Fig.5 (c)]では,エチレン分子が一個付着し た Si₁₅E₁*が強く観測されていることが分かる.5 秒反 応させた場合[Fig.5 (d)]では,付着するエチレン分子 の数によって反応性が大きく変わってくる様子がう かがえ,Si₁₅E₁⁺とSi₁₅E₄⁺の反応性が低いことが考えら れる.また15秒反応させた場合[Fig.5 (e)]で観測され た反応生成物は 5 秒反応させた場合の[Fig.5 (d)]とほ ぼ同じであった.従って今回の実験条件では5秒以降 においては反応が大きく進行していないと考えるこ とができる.この最終状態の存在は,逆反応も含めた 化学平衡とも考えられるが、シリコンクラスターに関 しては多くの構造異性体が存在し、イオンドリフトチ ューブを用いた反応実験^{7,8}や FT-ICR を用いたレー ザーアニーリング実験 %によって異性体によって反 応性が大きく異なることが知られていることから,各 構造異性体ごとに反応が終わった状態であるとも考



Fig. 5 Reaction Procee of Si_{15}^{+} with C_2H_4 . (a) Mass spectra measured by the direct-injection. (b) After SWIFTed. (c) Reacted for 0.5 sec. (d) 5sec. (e) 15 sec.

Fig. 6 Terminaly products of Chemical Reation of Si_{n^+} (n=11~18) with C_2H_4 for 10 sec. (Only n=10 and 11 were reacted for 5 sec)

えられる .また場合によってはエチレンの化学吸着後, その吸着サイトに応じた異性化が起こっている可能 性もある.

Fig. 6 は各サイズのシリコンクラスター正イオン (Si_n⁺ n=11~18)とエチレンを 10 秒間(Si₁₁⁺ Si₁₂⁺ のみ 5 秒間)反応させた場合の最終反応生成物である.いず れのサイズのクラスターでもこれ以上の時間反応さ せても反応はほとんど進行しなかった.一見して 12,15,16,17 量体では親クラスターはほとんど残って ないが 11,13,14,18 量体では相当量残っている.特に Si13⁺はこの条件ではほとんど反応していない.Jarrold らが測定したシリコンクラスターイオンとエチレン の反応定数 ⁷⁾も Si₁₃⁺が極端に小さく, 11,13 量体のそ れがその次に小さいことから、その傾向は良く似てい るといえる.反応生成物では,Si₁₁E⁺,Si₁₅E⁺,Si₁₅E⁺,,Si₁₅E⁺, $Si_{16}E_{1}^{+}, Si_{16}E_{3}^{+}, Si_{17}E_{2}^{+}, Si_{18}E_{1}^{+}, などが安定にのこるマジ$ ックナンバーになっている.なかでも $Si_{15}E_4^+$, $Si_{16}E_3^+$, Si₁₇E₂⁺, Si₁₈E₁⁺,等のシリコン原子数とエチレン分子数 の合計が19となる反応生成物が特異的に安定的であ る点は非常に興味深く、吸着サイトがエチレンによっ て埋められているようなモデルを予想させる.

4. 今後の展望

今回の研究によって、シリコンクラスターとエチレンの反応の経時変化を観測するでき、新たに設計制作した FT-ICR 質量分析装置で「数分オーダー」で ICR セルにトラップ出来ることを確認した.シリコンクラスターは構造異性体が多く存在すること知られているが今回の結果だけでは構造異性体に関する情報が乏しいため、今後はある特定の反応生成物に対する反応性やレーザーアニーリング実験を行い構造異性体についての詳細な検討を行っていく予定である.また正イオンのみでなく負イオンの反応実験や反応ガスを変えて実験を行い、シリコンクラスターの幾何構造および電子状態を総括的に追求していく計画である.

References

S. Maruyama et al., Rev. Sci. Instrum., **61**, 3686,(1990).
M. L. Mandich et al., J. Chem. Phys., **86**, 4245, (1987).
W. R. Creasy et al., J. Phys. Chem., **91**, 2848, (1987).
L. R. Anderson et al., Chem. Phys. Lett., 176, 348, (1991).
J. M. Alford et al., J. Chem. Phys., **94**, 2618, (1991).
S. Maruyama et al., J. Chem. Phys., **93**, 5349, (1990).
K. M. Creegan et al., J. Am. Chem. Soc., **112**, 3768, (1990).
M. F. Jarrold et al., J. Chem. Phys., **96**, 9180, (1992).